

**1 適用範圍:**

1.1 本承認書適用於本公司所生產的無鉛、無鹵素之 RTR系列精密型厚膜晶片電阻器。

1.2 本公司之無鉛產品意指符合RoHS要求的端電極無鉛，而存在於電阻層玻璃材料中的鉛是符合RoHS的鉛排外條款

**2 型別名稱:**

(例)

	<b>RTR</b>		<b>01</b>		<b>1002</b>		<b>D</b>		<b>TH</b>
型別	尺寸 (參考 3.規格表)		電阻值		容差		包裝型式 (參考包裝規格書)		
精密型厚膜 晶片電阻器	01(0201)		4-碼	EX. 10.2Ω=10R2 10KΩ=1002	B =± 0.1% D=± 0.5% F=± 1%		TH : 2 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs		

**3 規格表:**

3.1 阻值範圍: ≥ 1Ω

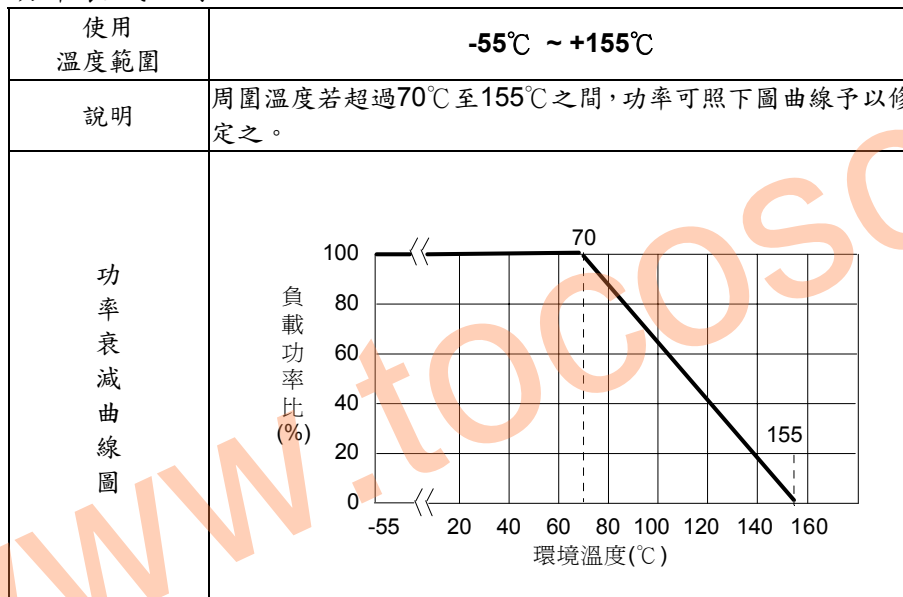
型別尺寸	額定 功率	最高 額定電壓	最高 過負荷電壓	T.C.R. (ppm/°C) 溫度係數	阻值範圍	
					B(±0.1%)、D(±0.5%) E-24、E-96	F(±1%) E-24、E-96
RTR01 (0201)	$\frac{1}{20}$ W	30V	60V	±100	10Ω ≤ R ≤ 1MΩ	10Ω ≤ R ≤ 1MΩ
RTR02 (0402)	$\frac{1}{16}$ W	50V	100V	±50	100Ω ≤ R ≤ 1MΩ	100Ω ≤ R ≤ 1MΩ
				±100	----	1Ω ≤ R < 10Ω
RTR03 (0603)	$\frac{1}{10}$ W	75V	150V	±50	100Ω ≤ R ≤ 1MΩ	100Ω ≤ R ≤ 1MΩ
				±100	----	1Ω ≤ R < 10Ω
RTR05 (0805)	$\frac{1}{8}$ W	150V	300V	±50	100Ω ≤ R ≤ 1MΩ	100Ω ≤ R ≤ 1MΩ
				±100	----	1Ω ≤ R < 10Ω
RTR06 (1206)	$\frac{1}{4}$ W	200V	400V	±50	100Ω ≤ R ≤ 1MΩ	100Ω ≤ R ≤ 1MΩ
				±100	----	1Ω ≤ R < 10Ω
RTR12 (1210)	$\frac{1}{2}$ W	200V	400V	±50	100Ω ≤ R ≤ 1MΩ	100Ω ≤ R ≤ 1MΩ
				±100	----	1Ω ≤ R < 10Ω
RTR20 (2010)	$\frac{3}{4}$ W	200V	400V	±50	100Ω ≤ R ≤ 1MΩ	100Ω ≤ R ≤ 1MΩ
				±100	----	1Ω ≤ R < 10Ω
RTR25 (2512)	1W	200V	400V	±50	100Ω ≤ R ≤ 1MΩ	100Ω ≤ R ≤ 1MΩ
				±100	----	1Ω ≤ R < 10Ω
使用溫度範圍				-55°C ~ +155°C		

IE		QA		Sales	備註	發行管制章 DATA Center.
制訂	審查	核准	會簽	會簽	非發行管制文件 自行注意版本更新 非經允許，禁止自行影印文件	
						Series No. <b>60</b>

3.2 阻值範圍: <math> < 1\Omega </math>

型別尺寸	額定功率	最高額定電流	最高過負荷電流	T.C.R (ppm / °C) 溫度係數	阻值範圍
					F(±1%) E-96
RTR05 (0805)	$\frac{1}{8}$ W	0.83A	2.08A	±100	$150\text{ m}\Omega \leq R < 1\Omega$
RTR06 (1206)	$\frac{1}{4}$ W	1.29A	1.94A	±100	$150\text{ m}\Omega \leq R < 1\Omega$
RTR20 (2010)	$\frac{3}{4}$ W	2.50A	6.25A	±100	$120\text{ m}\Omega \leq R < 1\Omega$
RTR25 (2512)	1W	2.89A	7.22A	±100	$120\text{ m}\Omega \leq R < 1\Omega$
使用溫度範圍				-55°C ~ +155°C	

3.3 功率衰減曲線



備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

### 3.4 額定電壓或額定電流:

#### 3.4.1 阻值範圍: $\geq 1\Omega$

額定電壓:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms)電壓。

可用下列公式求得,但求得之值若超過規格表內之最高電壓時,則以最高額定電壓為其額定電壓。

$$E = \sqrt{R \times P}$$

E=額定電壓(V)

P=額定功率(W)

R=公稱阻值( $\Omega$ )

#### 3.4.2 阻值範圍: $< 1\Omega$

額定電壓:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms)電壓。

可用下列公式求得,但求得之值若超過規格表內之最高電流時,則以最高額定電流為其額定電流。

$$I = \sqrt{P/R}$$

I=額定電流(A)

P=額定功率(W)

R=公稱阻值( $\Omega$ )

www.tocosc.com

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

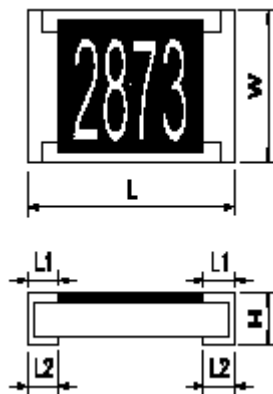
註

非經允許,禁止自行影印文件

Series No. 60

**4 尺寸:**

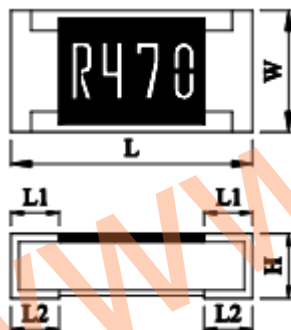
4.1 阻值範圍:  $\geq 1\Omega$



Unit:mm

Dimension		L	W	H	L1	L2
Type	Size Code					
RTR01	0201	0.60±0.03	0.30±0.03	0.23±0.03	0.15±0.05	0.15±0.05
RTR02	0402	1.00±0.10	0.50±0.05	0.30±0.05	0.20±0.10	0.25±0.10
RTR03	0603	1.60±0.10	0.80±0.10	0.45±0.10	0.30±0.15	0.30±0.15
RTR05	0805	2.00±0.10	1.25±0.10	0.50±0.10	0.35±0.20	0.35±0.15
RTR06	1206	3.05±0.10	1.55±0.10	0.50±0.10	0.45±0.20	0.35±0.15
RTR12	2010	3.05±0.10	2.55±0.10	0.55±0.10	0.50±0.20	0.50±0.20
RTR20	2010	5.00±0.20	2.50±0.20	0.55±0.10	0.60±0.20	0.60±0.20
RTR25	2512	6.30±0.20	3.20±0.20	0.55±0.10	0.60±0.20	0.60±0.20

4.2 阻值範圍:  $< 1\Omega$



Unit:mm

Dimension		L	W	H	L1	L2
Type	Size Code					
RTR05	0805	2.00±0.10	1.25±0.10	0.50±0.10	0.35±0.20	0.35±0.20
RTR06	1206	3.05±0.10	1.55±0.10	0.50±0.10	0.45±0.20	0.65±0.15
RTR20	2010	5.00±0.10	2.50±0.10	0.60±0.10	0.65±0.20	0.65±0.20
RTR25	2512	6.40±0.20	3.20±0.10	0.60±0.10	0.65±0.20	0.65±0.20

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

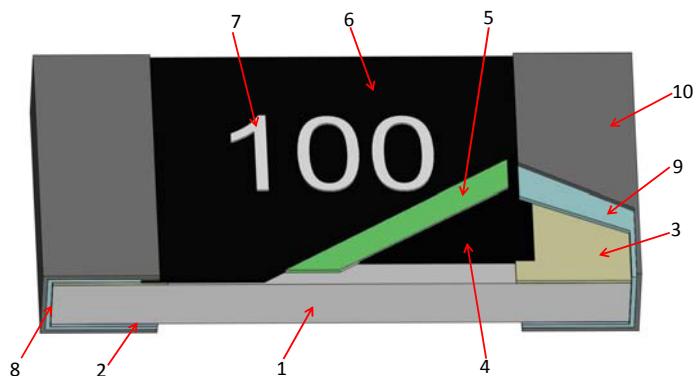
註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. **60**

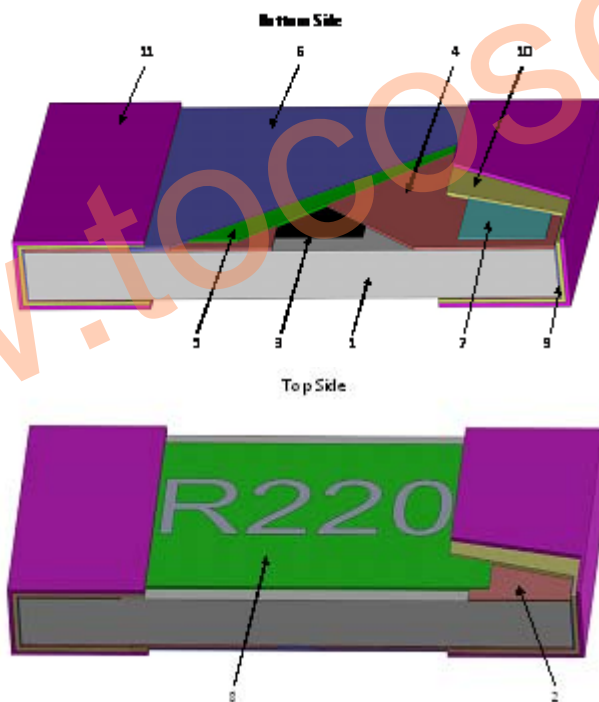
5 結構圖:

5.1 阻值範圍:  $\geq 1\Omega$



1	陶瓷基板	Ceramic substrate	6	2nd 保護層	2nd Protective coating
2	背面內部電極	Bottom inner electrode	7	字碼	Marking
3	正面內部電極	Top inner electrode	8	側面內部電極	Terminal inner electrode
4	電阻層	Resistive layer	9	Ni 層電鍍	Ni plating
5	1st 保護層	1st Protective coating	10	Sn 層電鍍	Sn plating

5.2 阻值範圍:  $< 1\Omega$



1	陶瓷基板	Ceramic substrate	7	C3層	C3 layer
2	正面內部電極	Top inner electrode	8	G2+MK層	G2 layer+Marking
3	電阻層	Resistive layer	9	側面內部電極	Terminal inner electrode
4	背面內部電極	Bottom inner electrode	10	Ni層電鍍	Ni plating
5	1st保護層	1st Protective coating	11	Sn層電鍍	Sn plating
6	2nd保護層	2nd Protective coating			

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

## 6 信賴性試驗項目:

### 6.1 電氣性能試驗(Electrical Performance Test)

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格														
		Resistors														
Temperature Coefficient of Resistance 溫度係數	$TCR \text{ (ppm/}^\circ\text{C)} = \frac{(R2 - R1)}{R1 (T2 - T1)} \times 10^6$ R1:室溫下量測之阻值(Ω) R2:-55°C或+125°C下量測之阻值(Ω) T1:室溫之溫度(°C) T2:-55°C或+125°C之溫度(°C)。 依據 JIS-C5201-1 4.8	參考3.規格表														
Short Time Overload 短時間過負荷	施加2.5倍的額定電壓5秒，靜置30分鐘以上再量測阻值變化率。(額定電壓值請參考 3.規格表)  依據 JIS-C5201-1 4.13	1.阻值範圍: ≥ 1Ω $\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.05\Omega)$ 2.阻值範圍: < 1Ω $\Delta R\% = \pm(2.0\% + 0.001\Omega)$ 外觀無損傷，無短路或燒毀現象。														
Insulation Resistance 絕緣電阻試驗	將晶片電阻置於治具上，在正負極施加100VDC一分鐘後，測量電極與保護層及電極與基板(底材)間之絕緣電阻值 依據 JIS-C5201-1 4.6	≥ 10 <sup>9</sup> Ω														
Dielectric Withstand Voltage 絕緣耐電壓	將晶片電阻置於治具上，在正、負極施加VAC (參考下列) RTR05、06、12、20、25 用500 VAC一分鐘 RTR01、02、03用300 VAC一分鐘  依據 JIS-C5201-1 4.7	無短路或燒毀現象。														
Intermittent Overload 斷續過負荷	置於恆溫箱中，施加2.5倍額定電壓，1秒ON，25秒OFF， $10,000^{+400}_{-0}$ 計 次取出靜置60分鐘後量測阻值變化量。 依據 JIS-C5201-1 4.13	1.阻值範圍: ≥ 1Ω $\Delta R\% = \pm(5.0\% + 0.10\Omega)$ 2.阻值範圍: < 1Ω $\Delta R\% = \pm(5.0\% + 0.001\Omega)$ 外觀無損傷，無短路或燒毀現象。														
Noise Level 雜音測驗	依據 JIS-C5201-1 4.12 測試方法。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>阻值範圍</th> <th>雜音(Noise)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R &lt; 100Ω</td> <td>≤ -10db (0.32 uV/V)</td> </tr> <tr> <td>100Ω ≤ R &lt; 1KΩ</td> <td>≤ 0db (1.0 uV/V)</td> </tr> <tr> <td>1KΩ ≤ R &lt; 10KΩ</td> <td>≤ 10db (3.2 uV/V)</td> </tr> <tr> <td>10KΩ ≤ R &lt; 100KΩ</td> <td>≤ 15db (5.6 uV/V)</td> </tr> <tr> <td>100KΩ ≤ R &lt; 1MΩ</td> <td>≤ 20db (10 uV/V)</td> </tr> <tr> <td>1MΩ ≤ R</td> <td>≤ 30db (32 uV/V)</td> </tr> </tbody> </table>	阻值範圍	雜音(Noise)	R < 100Ω	≤ -10db (0.32 uV/V)	100Ω ≤ R < 1KΩ	≤ 0db (1.0 uV/V)	1KΩ ≤ R < 10KΩ	≤ 10db (3.2 uV/V)	10KΩ ≤ R < 100KΩ	≤ 15db (5.6 uV/V)	100KΩ ≤ R < 1MΩ	≤ 20db (10 uV/V)	1MΩ ≤ R	≤ 30db (32 uV/V)
阻值範圍	雜音(Noise)															
R < 100Ω	≤ -10db (0.32 uV/V)															
100Ω ≤ R < 1KΩ	≤ 0db (1.0 uV/V)															
1KΩ ≤ R < 10KΩ	≤ 10db (3.2 uV/V)															
10KΩ ≤ R < 100KΩ	≤ 15db (5.6 uV/V)															
100KΩ ≤ R < 1MΩ	≤ 20db (10 uV/V)															
1MΩ ≤ R	≤ 30db (32 uV/V)															

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

6.2 機械性能試驗(Mechanical Performance Test)

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格
		Resistors
Core Body Strength 本體強度	使用R0.5的測試探針在本體中央向下施加10N { 1.02 kgf } 的負載持續10 sec。 1.RTR02、03測試探針R0.2 2.RTR05、06、12、20、25測試探針R0.5 (RTR01不適用) 依據 JIS-C5201-1 4.15	1.阻值範圍: $\geq 1\Omega$ 其它型別: $\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.05\Omega)$ 2.阻值範圍: $< 1\Omega$ $\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.001\Omega)$ 外觀無損傷, 側導無裂痕
Terminal Strength 端電極拉力測試	測試項目一:將電阻焊在電路板上, 在電阻背面施以5N的力量持續10 sec後, 檢查側導體外觀。(RTR01:3N) 測試項目二:將電阻焊在電路板上, 逐漸施加力量於電阻背面, 測試端電極最大剝離強度。 依據 JIS-C5201-1 4.16	項目一:外觀無損傷, 無側導脫落及本體斷裂發生。 項目二:RTR01 $\geq 3N$ 其它型別: $\geq 5N$
Resistance to Solvent 耐溶劑性試驗	浸於20~25°C異丙醇溶劑中5±0.5分鐘後, 取出靜置48 hr以上, 再量測阻值變化率。 依據 JIS-C5201-1 4.29	1.阻值範圍: $\geq 1\Omega$ $\Delta R\% = \pm(0.5\% + 0.05\Omega)$ 2.阻值範圍: $< 1\Omega$ $\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.001\Omega)$ 外觀無損傷, 無G2保護層及錫層被Leaching現象。
Solderability 焊錫性	前處理: 將晶片電阻放置於PCT試驗機內, 在溫度105°C、濕度100%及氣壓 $1.22 \times 10^5$ pa的飽和條件下進行4小時的老化測試, 取出後靜置於室溫下2小時。 測試方法: 將電阻浸於235±3°C之爐中2±0.5秒後取出置於顯微鏡下觀察焊錫面積。 依據 JIS-C5201-1 4.17	導體吃錫面積應大於95%。
Resistance to Soldering Heat 抗焊錫熱	◎測試項目一(焊錫爐測試): 浸於260+5/-0°C之錫爐中10 秒+1/-0, 取出靜置60分鐘以上, 再量測阻值變化率。 ◎測試項目二(焊錫爐測試) 浸於260+5/-0°C之錫爐中30+1/-0秒, 取出後洗淨。置於顯微鏡下觀察焊錫面積。 ◎測試項目三(電烙鐵試驗): 加熱溫度:350±10°C 電烙鐵加熱時間:3+1/-0 sec. 取電烙鐵加熱於電極兩端後, 取出靜置60分鐘以上, 再量測阻值變化率。 依據 JIS-C5201-1 4.18	試驗項目一: (1).阻值變化率 1.阻值範圍: $\geq 1\Omega$ $\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.05\Omega)$ 2.阻值範圍: $< 1\Omega$ $\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.001\Omega)$ (2).電極外觀無異常, 無側導脫落。 試驗項目二: (1).導體吃錫面積應大於95%。 (2).在電極邊緣處不應見到下層的物質(例如白基板)。 試驗項目三: (1).阻值變化率 1.阻值範圍: $\geq 1\Omega$ $\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.05\Omega)$ 2.阻值範圍: $< 1\Omega$ $\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.001\Omega)$ (2).電極外觀無異常, 無側導脫落。

備

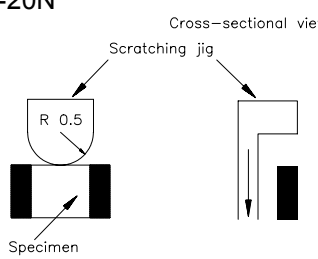
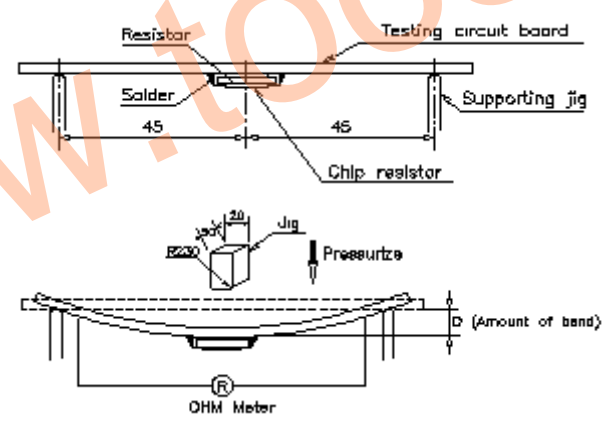
非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許, 禁止自行影印文件

Series No. 60

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格
		Resistors
Joint Strength of Solder 焊錫粘合強度	<p>前處理 將晶片電阻放置於PCT試驗機內，在溫度105℃、濕度100%及氣壓<math>1.22 \times 10^5</math> pa的飽和條件下進行4小時的老化測試，取出後靜置於室溫下2小時。</p> <p>◎測試項目一(固著性測試): 將晶片電阻焊於固著性測試板中，置於端電極測試機上，以半徑R0.5(0201:R0.1)之測試探針朝施力方向施加力量，並保持10 sec，於負荷下量測阻值變化率。</p> <p>力量：1.RTR01=5N 2.RTR02=10N 3.其它型別=20N</p>  <p>依據 JIS-C5201-1 4.32</p>	<p>試驗項目一:</p> <p>(1).阻值變化率 1.阻值範圍:<math>\geq 1\Omega</math> <math>\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.05\Omega)</math> 2.阻值範圍:<math>&lt; 1\Omega</math> <math>\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.001\Omega)</math></p> <p>(2).外觀無損傷、無側導脫落。</p> <p>試驗項目二:</p> <p>(1).阻值變化率 1.阻值範圍:<math>\geq 1\Omega</math> <math>\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.05\Omega)</math> 2.阻值範圍:<math>&lt; 1\Omega</math> <math>\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.001\Omega)</math></p> <p>(2).外觀無損傷、無側導脫落及本體斷裂發生。</p>
	<p>◎測試項目二(彎折性測試): 將晶片電阻焊於彎折性測試板中，置於彎折測試機上，在測試板中央施力下壓，於負荷下量測阻值變化率。</p> <p>下壓深度(D):RTR02、03、05=5mm RTR01、06、12=3mm RTR20、25=2mm</p>  <p>依據 JIS-C5201-1 4.33</p>	
Vibration 耐振性試驗	<p>將晶片電阻焊於測試板上施加一振動波 震動頻率:10Hz ~ 55Hz ~ 10Hz/分 振幅:1.5mm 測試時間:6hrs(X.Y.Z3個方向各2hrs) 依據 JIS-C5201-1 4.22</p>	<p>1.阻值範圍:<math>\geq 1\Omega</math> <math>\Delta R\% = \pm(0.5\% + 0.05\Omega)</math> 2.阻值範圍:<math>&lt; 1\Omega</math> <math>\Delta R\% = \pm(1.0\% + 0.001\Omega)</math></p> <p>外觀無損傷</p>

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60



6.3 環境試驗(Environmental Test)

Item 項目	Conditions 條件	Specifications規格										
		Resistors										
Resistance to Dry Heat 耐熱性試驗	置於155±5°C之烤箱中1000+48/-0 hrs，取出靜置1hr以上再量測阻值變化率。  依據 JIS-C5201-1 4.25	1.阻值範圍:≥1Ω △R%=±(1.0%+0.05Ω) 2.阻值範圍:<1Ω △R%=±(1.0%+0.001Ω) 外觀無損傷，無短路及燒毀現象。										
Thermal Shock 冷熱沖擊	將晶片電阻置入冷熱沖擊機中，溫度為-55°C 15分鐘，+125°C 15分鐘，共計循環300次後取出，靜置60分鐘再量測阻值變化率。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th colspan="2">測試條件</th> </tr> <tr> <td>最低溫度</td> <td>-55±5°C</td> </tr> <tr> <td>最高溫度</td> <td>125±5°C</td> </tr> <tr> <td>溫度保留時間</td> <td>15 分鐘</td> </tr> </table> 依據 MIL-STD 202 Method 107	測試條件		最低溫度	-55±5°C	最高溫度	125±5°C	溫度保留時間	15 分鐘	1.阻值範圍:≥1Ω △R%=±(0.5%+0.05Ω) 2.阻值範圍:<1Ω △R%=±(1.0%+0.001Ω) 外觀無損傷，無短路及燒毀現象。		
測試條件												
最低溫度	-55±5°C											
最高溫度	125±5°C											
溫度保留時間	15 分鐘											
Loading Life in Moisture 耐濕負荷	置於溫度40±2°C相對濕度90~95%恆溫恆濕槽中，並施加額定電壓，90分鐘ON，30分鐘OFF，共1,000 hrs取出靜置60分鐘以上再量測阻值變化率。  依據 JIS-C5201-1 4.24	1.阻值範圍:≥1Ω RTR01：△R%=±(1.0%+0.05Ω) 其他型別：△R%=±(0.5%+0.05Ω) 2.阻值範圍:<1Ω △R%=±(2.0%+0.001Ω) 外觀無損傷，無短路及燒毀現象。										
Load Life 負荷壽命	置於70±2°C之烤箱中施加額定電壓，90分鐘ON，30分鐘OFF，共1,000 hrs取出靜置60分鐘以上再量測阻值變化率。  依據 JIS-C5201-1 4.25	1.阻值範圍:≥1Ω RTR01：△R%=±(1.0%+0.05Ω) 其他型別：△R%=±(0.5%+0.05Ω) 2.阻值範圍:<1Ω △R%=±(2.0%+0.001Ω) 外觀無損傷，無短路及燒毀現象。										
Low Temperature Operation 低溫操作	將晶片電阻放置-55°C恆溫箱中60分鐘，施加額定電壓45分鐘，停止施壓15分鐘取出後靜置8±1hr再量測阻值變化率。  依據MIL-R-55342D 4.7.4	1.阻值範圍:≥1Ω △R%=±(0.5%+0.05Ω) 2.阻值範圍:<1Ω △R%=±(1.0%+0.001Ω) 外觀無損傷，無短路及燒毀現象。										
Whisker試驗	◎測試項目(冷熱衝擊測試): 將晶片電阻置放於冷熱衝擊試驗箱內，並依下列條件做測試，試驗後置於室溫下2小時。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th colspan="2">測試條件</th> </tr> <tr> <td>最低儲存溫度</td> <td>-55+0/-10°C</td> </tr> <tr> <td>最高儲存溫度</td> <td>85+10/-0°C</td> </tr> <tr> <td>溫度保留時間</td> <td>10分</td> </tr> <tr> <td>溫度循環次數</td> <td>1,500</td> </tr> </table> ◎檢查 將放大鏡的倍數調至40或大於40的倍數下做視察和測試，如果此方法難做出判斷，我們可以改用掃描電子顯微鏡(SEM)，且將倍數調至1000或大於1000倍數下做視察和測試。 依據JEDEC Standard NO.22A121 class2.	測試條件		最低儲存溫度	-55+0/-10°C	最高儲存溫度	85+10/-0°C	溫度保留時間	10分	溫度循環次數	1,500	Whisker長度在50µm之內。
測試條件												
最低儲存溫度	-55+0/-10°C											
最高儲存溫度	85+10/-0°C											
溫度保留時間	10分											
溫度循環次數	1,500											

備

非 發 行 管 制 文 件  
自 行 注 意 版 本 更 新

發行管制章 DATA Center.

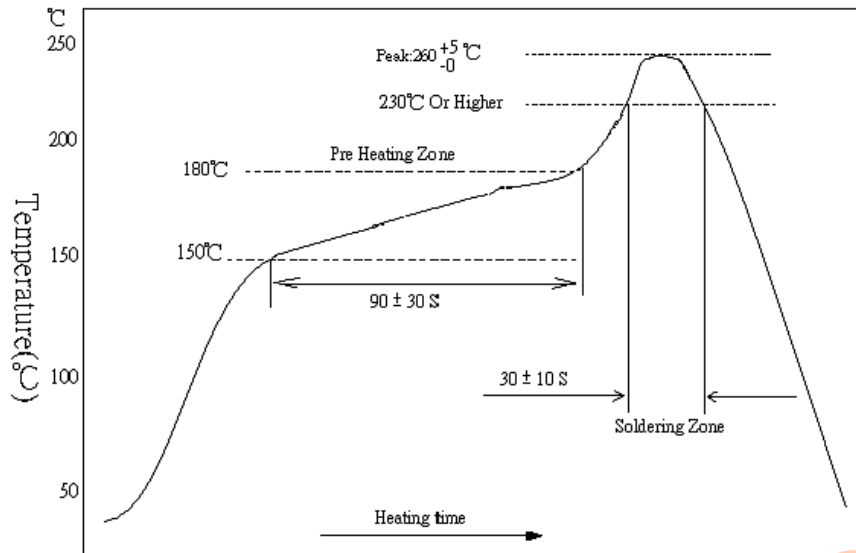
註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

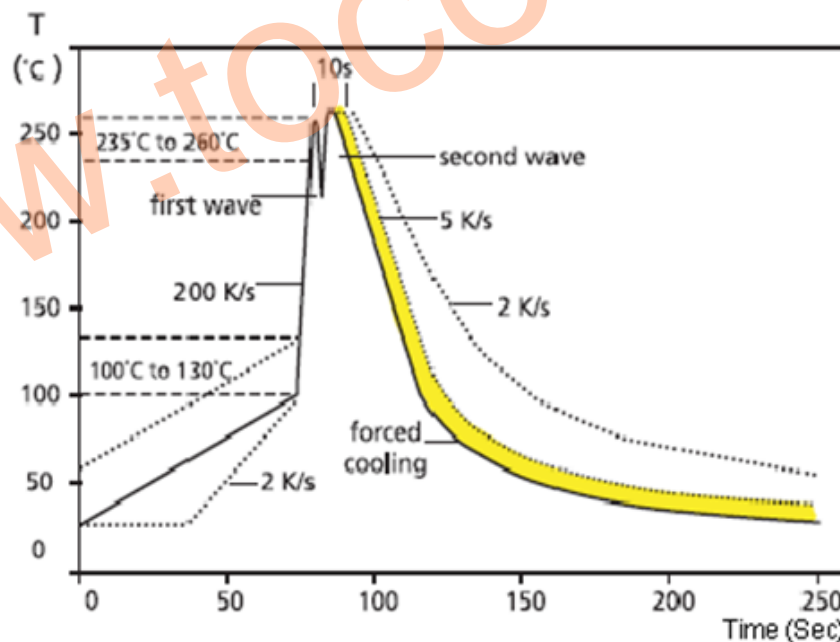
7 建議焊錫條件:

7.1 Lead Free IR Reflow Soldering Profile



備註:零件最高耐溫 $260 +5/-0$  °C, 10秒。

7.2 Lead Free Double-Wave Soldering Profile(適用0603(含)以上之產品)



7.3 烙鐵焊錫方法: $350 \pm 10$  °C 3秒之內。

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

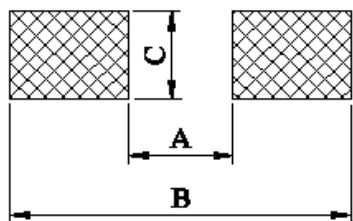
註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

8 建議Land Pattern Design(For Reflow Soldering) :

Unit:mm



DIM TYPE	A	B	C
RTR01	0.3	1.0	0.4
RTR02	0.5	1.5	0.6
RTR03	0.8	2.1	0.9
RTR05	1.2	3.0	1.3
RTR06	2.2	4.2	1.6
RTR12	2.2	4.2	2.8
RTR20	3.5	6.1	2.8
RTR25	3.8	8.0	3.5

9 鍍層厚度:

9.1 鍍層厚度:  $\geq 1\mu\text{m}$

9.2 純錫:  $\geq 3\mu\text{m}$

9.3 電鍍純錫為霧錫

10 阻值測試包裝標準量測位置:

背面電極量測		Unit : mm		
		DIM TYPE		
<p>⊙ Current Terminal</p> <p>⊖ Voltage Terminal</p>		A	B	
		RTR01	0.44±0.05	0.22±0.05
		RTR02	0.80±0.05	0.24±0.05
		RTR03	1.35±0.05	0.35±0.05
		RTR05	1.80±0.05	0.35±0.05
		RTR06	2.90±0.05	0.35±0.05
		RTR12	2.90±0.05	0.35±0.05
		RTR20	4.50±0.05	1.15±0.05
		RTR25	5.90±0.05	1.60±0.05

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註



非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

**11 儲存期限:**

11.1 在儲存環境 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、 $60\pm 15\%$ 之條件下可儲存二年。

**12 電子信息產品標示外箱上以下列標籤進行標示:(外銷中國大陸)**

	
<p>電子信息產品污染控制標誌</p>	<p>包裝回收標誌</p>

**13 附件**

13.1 文件修訂記錄表 (QA-QR-027)

www.tocosc.com

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章 DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60